

AP8012H

Chipown

低待机功耗离线式开关电源IC

概述

AP8012H芯片内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET，适用于小功率离线式开关电源。该芯片提供了完整的智能化保护功能，包括过流保护，欠压保护，过压保护，过温保护和软启动功能。间歇工作模式能够降低系统处于待机模式时的功耗；抖频技术有助于改善EMI特性。该芯片还内置高压启动模块，保证系统能迅速启动。

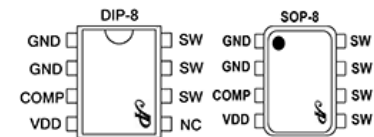
特征

- 内置800V高雪崩能力智能功率MOSFET
- 满足85~265V宽AC输入工作电压
- 全电压半封闭式稳态输出功率6W(DIP-8封装)
- 抖频技术改善EMI特性
- 间歇工作模式
- 软启动
- 内置高压启动电路
- 保护功能
 - ◇ 过流保护 (OCP)
 - ◇ 过温保护 (OTP)
 - ◇ VDD过压保护

应用领域

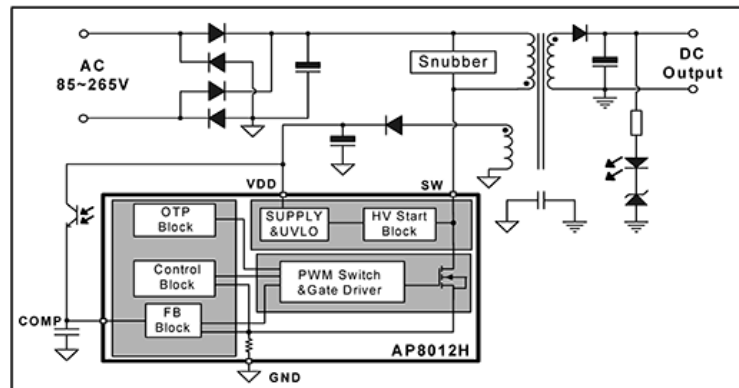
- 电磁炉电源
- 小家电辅助电源

封装/订购信息



订购代码	封装
AP8012HNEC-TIE	DIP-8
AP8012HNEC-TIL	DIP-8
AP8012HSEC-R1	SOP-8

典型应用



无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话: +86 (510) 85217718 网址: <http://www.chipown.com> RevA.1801 1 / 10

AP8012H

管脚定义

表 1. 管脚定义

SOP-8 管脚标号	DIP-8 管脚标号	管脚名	管脚功能描述
1,2	1,2	GND	功率MOS以及控制电路的参考地
3	3	COMP	反馈输入脚，用以确定功率MOS的峰值电流
4	4	VDD	控制电路的供电电源，启动时由高压启动管对VDD电容进行充电，当达到UVLO启动电压时，启动过程结束
-	5	NC	空脚(DIP-8可接SW)
5,6,7,8	6,7,8	SW	功率MOS的漏极

典型功率

表 2. 典型功率

封装	输入电压	稳态功率 ⁽¹⁾	峰值功率 ⁽²⁾
SOP-8	85-265 V _{AC}	3.6W(12V300mA)	6W(12V500mA)
DIP-8	85-265 V _{AC}	6W(12V500mA)	8.4W(12V700mA)

备注:

1. 稳态功率在半封闭式 75°C 环境下测试, 持续时间大于 2 小时。
2. 峰值功率在半封闭式 75°C 环境下测试, 持续时间大于 1min。

极限工作范围

VDD 脚耐压.....	-0.3~45V
SW 脚耐压.....	-0.3~750V
COMP 脚耐压.....	-0.3~7V
结工作温度范围.....	-40~150°C
存储温度范围.....	-55~150°C
管脚焊接温度 (10秒).....	260°C
封装热阻 R _{θJC} (SOP-8).....	80°C/W
封装热阻 R _{θJC} (DIP-8).....	40°C/W
人体模式 ESD 能力 ^① (HBM, ESDA/JEDEC JDS-001-2014).....	±4kV
空气模式 ESD 能力 ^② (静电测试仪对芯片引脚直接放电).....	8kV
漏极脉冲电流 (T _{pulse} =100us).....	2A

- 备注: 1. 产品委托第三方严格按照芯片级ESD标准(ESDA/JEDEC JDS-001-2014)中的测试方式和流程进行测试。
2. 此项测试为企业内部标准, 结果仅供参考。

电气特性(T_j = 25°C, V_{DD} = 15 V; 特殊情况另行说明)

表 3. 功率部分

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
B _{VDSS}	功率管耐压	I _{SW} = 250uA	750	820		V
I _{OFF}	关态漏电流	V _{SW} = 550V			100	uA
R _{DSON}	功率管导通电阻	I _{SW} = 400mA, T _j = 25°C		18		Ω

表 4. 控制部分

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
欠压保护部分						
V _{START}	欠压保护启动电压	V _{COMP} = 0V	13	14.5	16	V
V _{STOP}	欠压保护关断电压	V _{COMP} = 0V	7	8	9	V
V _{HYS}	欠压保护回差			6.5		V
V _{RST}	VDD 重新启动电压		5.5	6	6.5	V
振荡器部分						
F _{OSC}	开关频率	T _A = 25°C	40	45	50	kHz
FD	抖频范围			±5		kHz
FM	调制频率			167		Hz
D _{MAX}	最大占空比		65	80	90	%
反馈部分						
I _{COMP}	COMP关断电流			1.2		mA
R _{COMP}	COMP脚输入阻抗			1.15		kΩ
限流部分						
I _{LIM}	峰值电流	T _A = 25°C	0.44	0.55	0.66	A
T _{LEB}	最小导通时间	LEB time		350		ns
t _{SS}	软启动时间			10		ms
I _{D, BM}	间歇工作模式工作电流			100		mA

过温保护部分						
T_{SD}	过温保护温度		140	170	-	°C
T_{HYST}	过温保护回差			30		°C
工作电流部分						
I_{CH}	启动管充电电流 (SW 脚)	$V_{DRAIN} = 105 V,$ $V_{COMP} = GND,$ $V_{DD} = 12 V$		-1.2		mA
AP8012H(E)	I_{DD} 工作电流	$V_{DD} = 16 V,$ $V_{COMP} = 0V$		4		mA
AP8012H(L)	I_{DD} 工作电流	$V_{DD} = 16 V,$ $V_{COMP} = 0V$		0.6		mA
V_{DD}	工作电压范围	After turn-on	10		35	V
V_{OVP}	VDD过压保护		37	40	43	V
I_{DD_OFF}	VDD欠压时消耗电流	$V_{DD} = 6V$	100		400	uA

典型应用

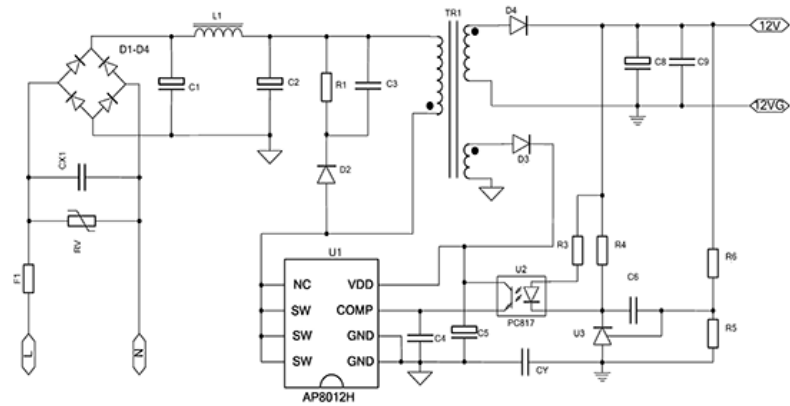
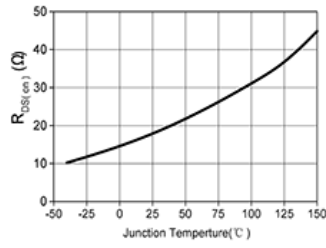
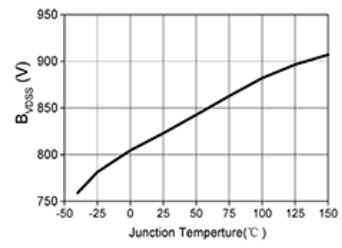


图 1. 应用典型线路

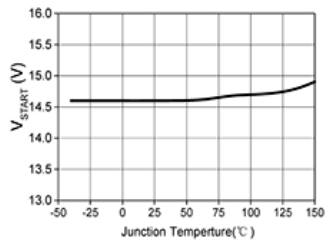
典型参数曲线



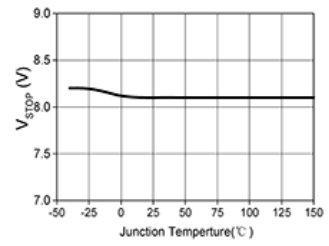
(a) $R_{DS(on)}$ vs T_j



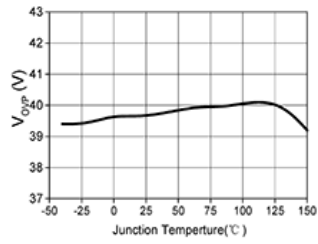
(b) B_{VDSS} vs T_j



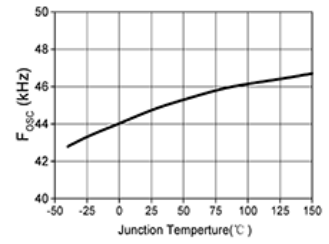
(c) V_{START} vs T_j



(d) V_{STOP} vs T_j



(e) V_{OVP} vs T_j



(f) F_{Osc} vs T_j

功能描述

1. 启动

AP8012H 内部集成高压启动电路，启动时 SW 脚对 VDD 电源提供充电电流。当 VDD 电压达到 V_{START} 电压时，内部高压启动电路关闭，VDD 电容的能量由变换器提供；当 VDD 电压低于 V_{STOP} ，芯片并不会马上重新启动，只有当 VDD 电压低到 V_{RST} 时，高压启动管开启并为 VDD 电容充电，直至 VDD 电压达到 V_{START} 。

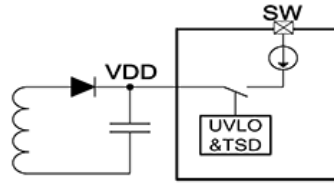


图 2. 启动电路

2. 软启动

启动阶段，漏极的最大峰值电流限制逐步的提高；可以大大减小器件的应力，防止变压器饱和。软启动时间典型值为10ms。

3. 输出驱动

AP8012H采用优化的图腾柱结构，通过合理的输出驱动能力以及死区时间，得到较好的EMI特性和较低的损耗。

4. 振荡器

AP8012H的振荡频率固定在45 kHz，无需外围电路进行设置。它含有特有的频率抖动技术，可以改善EMI特性。

5. 反馈回路

反馈脚通过控制MOSFET的开通和关断实现输出的稳定。不同于传统的电压模式PWM控制电路，AP8012H采用电流控制方式（如图3所示），通过内部采样管得到流过功率MOS的电流。从COMP脚流入的电流通过R2进行采样，采样电压（VR2）跟内部基准VR1比较；当VR2的电压超过内部基准电压时，则关断MOSFET实现环路控制。

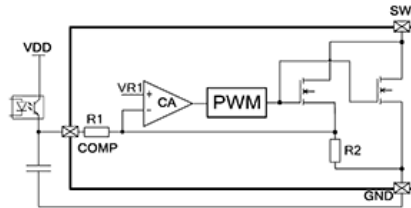


图 3. 反馈电路

6. 前沿消除

由于SW脚的寄生电容，当MOS开通瞬间存在较大的峰值电流，如果采样MOSFET采样到该信号，芯片会进入过流保护状态。为了防止MOS开通瞬间引起电路误触发，过流保护电路在功率管开通一段时间（典型值350ns）后才开始工作。

7. 欠压锁定

由于异常情况导致功率管被关闭后，VDD脚电压由于没有提供能量将会一直下降，当VDD电压下降到VDD重新启动电压（VRST，典型值6V）时，欠压锁定电路被复位，内部高压电流源重新开始给VDD提供能量。直至VDD电压上升到欠压锁定解除点（典型值14.5V）时，芯片开始正常工作，功率管正常开启和关闭。通过这种控制方法，芯片在异常情况消除后能自动重新启动。

8. 过温保护

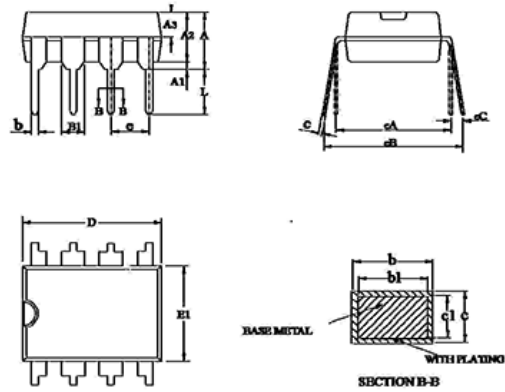
功率MOSFET和控制芯片集成在一起，能保证温度采样电路更准确地采样功率管的温度信号，从而更及时地对功率管进行保护。当芯片结温超过170°C时（典型值），芯片进入过温保护状态；直至结温回到140°C（典型值）时，芯片重新开始工作。温度保护存在滞回，保证芯片不会出现热振荡现象。

封装尺寸 (DIP-8)

表 5. DIP-8 封装尺寸

符号	尺寸	最小值(mm)	最大值(mm)	符号	尺寸	最小值(mm)	最大值(mm)
A		3.60	4.00	e1		0.23	0.27
A1		0.51	—	D		9.05	9.45
A2		3.00	3.40	E1		6.15	6.55
A3		1.55	1.65	e		2.54BSC	
b		0.44	0.53	e A		7.62BSC	
b1		0.43	0.48	e B		7.62	9.30
B1		1.52BSC		e C		0.00	0.84
c		0.24	0.32	L		3.00	—

图 4. 外形示意图



表层丝印	封装
AP8012H YWWXXXXX	DIP-8

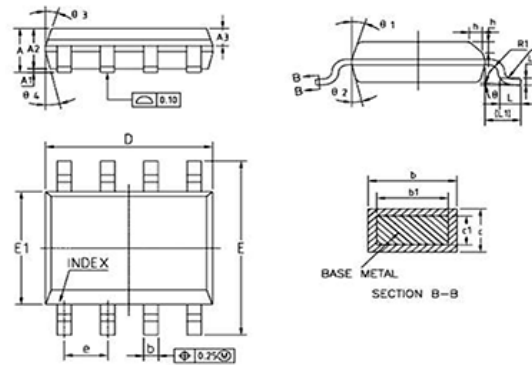
备注: Y: 年份代码; WW: 周代码; XXXXX: 内部代码

封装尺寸 (SOP-8)

表 6. SOP-8 封装尺寸

尺寸 符号	最小(mm)	正常(mm)	最大(mm)	尺寸 符号	最小(mm)	正常(mm)	最大(mm)
A	1.35	1.55	1.75	L	0.45	0.60	0.80
A1	0.10	0.15	0.25	L1	1.04REF		
A2	1.25	1.40	1.65	L2	0.25BSC		
A3	0.50	0.60	0.70	R	0.07	—	—
b	0.38	—	0.51	R1	0.07	—	—
b1	0.37	0.42	0.47	h	0.30	0.40	0.50
c	0.17	—	0.25	θ	0°	—	8°
c1	0.17	0.20	0.23	θ1	15°	17°	19°
D	4.80	4.90	5.00	θ2	11°	13°	15°
E	5.80	6.00	6.20	θ3	15°	17°	19°
E1	3.80	3.90	4.00	θ4	11°	13°	15°
e	1.270 (BSC)						

图 5. 外形示意图



表层丝印	封装
AP8012H YWWXXXXX	SOP-8

备注: Y: 年份代码; WW: 周代码; XXXXX: 内部代码